

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 15 卷 第 6 期 1994 年 6 月

目 次

- 氢等离子体对(Pt 及其硅化物)/Si 界面的杂质/缺陷态和势垒的影响.....
.....丁孙安 许振嘉 (367)
- Si/Si_{1-x}Ge_x 应变层超晶格折叠声子能隙的精细测量
..... 张鹏翔 D. J. Lockwood J-M. Baribeau H. J. Labbé (373)
- 进一步提高氢离子敏场效应晶体管稳定性的研究.....
.....陈克铭 李国花 陈朗星 朱 燕 (383)
- 优质高阻异型厚层硅外延 IGBT 材料 n⁻/n⁺/p⁺.....杨漠华 黎展荣 (388)
- III 族镉源对LP-MOVPE 方法生长 In_{1-x}Ga_xAs 材料的影响.....
.....祝进田 胡礼中 刘式墉 (393)
- GaAs 表面等离子激元偏振子的激励以及它的偏光依赖性吴鼎祥 (397)
- 微氮硅单晶热处理性质研究.....杨德仁 姚鸿年 阙端麟 (402)
- 硅锗分子束外延层表面形貌的扫描隧道显微镜研究.....
周铁城 蔡 群 朱昂如 董树忠 盛 麓 俞鸣人 张翔九 王 迅 (409)
- 用非相干光时间延迟四波混频测量载流子复合时间.....
.....张希清 赵家龙 秦伟平 黄世华 (416)
- 微氮硅单晶中氧沉淀.....杨德仁 姚鸿年 阙端麟 (422)
- 硼掺杂多晶硅薄膜电阻率的温度特性.....刘晓为 张国威 刘振茂 理 峰 (429)
- Si⁺ 注入 InP 材料的欧姆接触特性研究.....
.....沈鸿烈 徐宏来 周祖尧 林梓鑫 邹世昌 (435)